# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

08236028

**PUBLICATION DATE** 

13-09-96

APPLICATION DATE

27-02-95

**APPLICATION NUMBER** 

07038874

APPLICANT: FUJITSU LTD;

INVENTOR:

MOCHIZUKI AKIHIRO;

INT.CL.

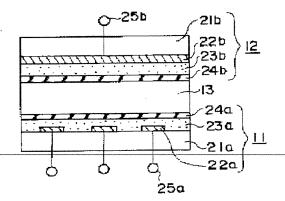
: H01J 11/02 H01J 11/00

TITLE

SECONDARY ELECTRON EMITTING

MATERIAL FOR PLASMA DISPLAY

AND PLASMA DISPLAY PANEL



ABSTRACT:

PURPOSE: To spread discharge margin voltage by replacing a part of Mg of constituting

MgO with Fe, Cr or V to lower discharge start voltage.

CONSTITUTION: The belt-shaped first display electrodes 22a, dielectric layer 23a and protecting layer 24a are laminated on a glass substrate 21a, to obtain a substrate 11. The belt-shaped second display electrode 22b, dielectric layer 23b and protecting layer 24b are laminated on a glass substrate 21b, to obtain a glass substrate 12. In these protecting layers 24a, 24b, an MgO film, replacing Mg with at least one element selected from Fe, Cr, V, is used. The substrates 11, 12 are superposed so that the protecting layers 24a, 24b are oppositely facing and the electrodes 22a, 22b are crossed, and inert gas for discharging is filled in a clearance 13 formed between the substrates 11, 12.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

# 特開平8-236028

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

FΙ 技術表示箇所 識別記号 庁内整理番号 (51) Int.Cl.<sup>6</sup> H 0 1 J 11/02 В H 0 1 J 11/02 K 11/0011/00

審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全 8 頁)

(71)出願人 000005223 特願平7-38874 (21)出願番号 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 (22)出願日 平成7年(1995)2月27日 (72)発明者 渦巻 拓也 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72)発明者 望月 昭宏 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (74)代理人 弁理士 岡本 啓三

(54)【発明の名称】 プラズマディスプレイ用二次電子放出材料及びプラズマディスプレイパネル

### (57)【要約】

【目的】 PDPにおいて誘電体層の保護層を形成する 2次電子放出材料の改良に関し、放電開始電圧を低く し、かつ放電マージン電圧を広くする。

【構成】 MgOを構成するMgの一部が少なくともF e, Cr及びVのうちいずれか一つの元素で置換された ことを含む。

10

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 MgOを構成するMgの一部が少なくともFe, Cr及びVのうちいずれか一つの元素で置換されたことを特徴とするプラズマディスプレイ用二次電子放出材料。

【請求項2】 前記MgOを構成するMgO一部がそれぞれ前記Fe, Cr及びVで置換され、かつ、前記VO量は前記Feと前記Crの総量よりも少ないことを特徴とする請求項1記載のプラズマディスプレイ用二次電子放出材料。

【請求項3】 2つの基板が間隙を挟んで対向し、該間隙に放電させるべき不活性ガスを封入してなるプラズマディスプレイパネルにおいて、

少なくとも一つの前記基板の前記不活性ガスと接する側の表面に請求項1又は請求項2記載の二次電子放出材料からなる保護層が形成されていることを特徴とするプラズマディスプレイバネル。

【請求項4】 前記2つの基板はそれぞれガラス基板上に帯状の電極と誘電体層と前記保護層とが順に積層されてなり、前記保護層同士が対面し、かつそれぞれの前記 20 電極が交差するように前記2つの基板が重ねられてなることを特徴とする請求項3記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項5】 前記2つの基板のうち、一方の前記基板はガラス基板上に互いに並行する帯状の放電維持電極対と誘電体層と前記保護層とが順に積層されてなり、他方の前記基板はガラス基板上に帯状の書き込み電極と蛍光体層とが順に積層されてなり、前記保護層と前記蛍光体層とが対面し、かつ前記電極対と前記書き込み電極とが交差するように前記2つの基板が重ねられてなることを 30 特徴とする請求項3記載のプラズマディスプレイパネル。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はプラズマディスプレイパネル(以下、PDPと称する。)における2次電子放出材料及びPDPに関し、より詳しくは、PDPにおいて誘電体層の保護層を形成する2次電子放出材料の改良及びこれを用いたPDPに関する。PDPには直接放電型(DC型PDP)と面放電型を採る間接放電型(AC型 40 PDP)があり、PDPは大画面化が容易なこと、自発光型で表示品質が良いこと、応答速度が速いことなどの特長がある。また、薄型化が可能なことから液晶表示デバイス(LCD)などとともに壁掛け用のディスプレイとして注目されている。将来、より高精彩化が望まれている。

【0002】DC型PDP, AC型PDPのいずれの場合も誘電体層の保護層としてMgOが用いられているが、より高精彩化するためには現在の放電開始電圧(Vf)を下げるとともに、動作の安定性を維持するため放 50

電維持最小電圧と放電維持最大電圧間の幅を広げる必要

[0003]

がある。

【従来の技術】図8は、従来例の面放電型のAC型PDPの断面図である。図8に示すように、背面ガラス基板1の上には並行する帯状の2つの表示電極2,3を一組とする放電維持電極対が形成されている。表示電極2,3は誘電体層4で被覆され、更に、誘電体層4上にMgのからなる薄い保護層5が形成されている。ここで、誘電体層4は表示電極への電圧印加により生じた電荷を蓄積するために設けられ、保護層5は放電により生じたイオンの衝突による誘電体層4の破壊を防ぐために設けられる。

【0004】一方、前面ガラス基板6の上には帯状のアドレス電極7と蛍光体層8が形成されている。上記の背面ガラス基板1と前面ガラス基板6は、保護層5と蛍光体層8が対向し、かつ表示電極2,3とアドレス電極7が交差するように重ね合わされる。保護層5と蛍光体層8の間には隙間9が形成され、その隙間9に放電を起こさせる不活性ガスが封入される。

【0005】次に、上記のPDPの動作について説明する。表示電極2,3間に放電維持電圧に相当するAC電圧を印加して誘電体層4に電荷を蓄積しておく。次に、アドレス電極7に放電開始電圧に達するようなAC電圧を印加すると、間隙に生ずる高電界により不活性ガスが電子とイオンに分離し、プラズマ化する。そして、電子とイオンが再結合する際に発生する紫外線を受けて蛍光体層8が発色する。以降は、誘電体層4に蓄積された電荷により放電維持電圧に相当するAC電圧を表示電極2,3間に印加するだけで不活性ガスが放電し、蛍光体層8が発色する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、AC型PDPの高精彩化の要求により表示電極2,3間の距離を狭くしようとすると、放電開始電圧が増大し、又は、誘電体層4の静電破壊を招く。このため、放電開始電圧が増大するとともに放電維持最小電圧も増大すると考えられる。更に、表示電極2,3間が狭くなった分だけそれらの間に発生する電界が増大し、誘電体層4の静電破壊電圧が低下するため、放電維持最大電圧の上限が制限を受ける。以上のように、PDPの高精彩化に伴い、放電維持最小電圧と放電維持最大電圧の差(放電マージン電圧)が小さくなる傾向がある。PDPを余裕をもって動作させ、その動作の安定化を図るためには、放電マージン電圧を広くしておくことが望ましい。

【0007】本発明は、上記の従来例の問題点に鑑みて 創作されたものであり、放電開始電圧を低くし、かつ放 電マージン電圧を広くすることができるPDPにおける 2次電子放出材料を提供することを目的とするものであ

—196**—** 

3

る。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】上記課題は、第1に、M gOを構成するMgの一部が少なくともFe, Cr及び Vのうちいずれか一つの元素で置換されたプラズマディ スプレイ用二次電子放出材料によって達成され、第2 に、前記MgOを構成するMgの一部がそれぞれ前記F e、Cr及びVで置換され、かつ、前記Vの量は前記F e と前記Crの総量よりも少ないことを特徴とする第1 の発明に記載のプラズマディスプレイ用二次電子放出材 料によって達成され、第3に、2つの基板が間隙を挟ん で対向し、該間隙に放電させるべき不活性ガスを封入し てなるプラズマディスプレイパネルにおいて、少なくと も一つの前記基板の前記不活性ガスと接する側の表面に 請求項1又は請求項2記載の二次電子放出材料からなる 保護層が形成されていることを特徴とするプラズマディ スプレイパネルによって達成され、第4に、前記2つの 基板はそれぞれガラス基板上に帯状の電極と誘電体層と 前記保護層とが順に積層されてなり、前記保護層同士が 対面し、かつそれぞれの前記電極が交差するように前記 20 2つの基板が重ねられてなることを特徴とする第3の発 明に記載のプラズマディスプレイパネルによって達成さ れ、第5に、前記2つの基板のうち、一方の前記基板は ガラス基板上に互いに並行する帯状の放電維持電極対と 誘電体層と前記保護層とが順に積層されてなり、他方の 前記基板はガラス基板上に帯状の書き込み電極と蛍光体 層とが順に積層されてなり、前記保護層と前記蛍光体層 とが対面し、かつ前記電極対と前記書き込み電極とが交 差するように前記2つの基板が重ねられてなることを特 徴とする第3の発明に記載のプラズマディスプレイパネ 30 ルによって達成される。

#### [0009]

【作用】プラズマディスプレイパネルの放電開始電圧は 保護層からの2次電子放出量により大きな影響を受け る。即ち、不活性ガスが電離して生じたイオンは保護層 に衝突して内部に進入する。この運動エネルギを受け て、保護層から2次電子が発生し、さらに電離を促進す る。従って、放電開始電圧を下げるためには保護層から の2次電子放出量を大きくすることが必要である。

[0010] また、2次電子放出量を大きくすることに 40 より、放電維持最小電圧が下がると考えられるので、放 電マージン電圧を広くするためにも2次電子放出量を大 きくする方がよいと考えられる。本願発明者は、イオン 衝撃に強いMgOを用いるとともに、そのMgの一部を 鉄 (Fe) 及びクロム (Cr) のうち少なくともいずれ かで置換することにより、放電マージン電圧を広くする ことができることを、実験により見いだした。特に、鉄 及びクロムに加えて、鉄及びクロムの総量と比べて少量 のバナジウム(V)を置換すれば、その効果が大きくな ることを見いだした。

【0011】また、上記置換により保護層からの2次電 子放出量が大きくなると考えられるため、放電開始電圧 を低くすることも可能である。

#### [0012]

【実施例】次に、図面を参照しながら本発明の実施例に ついて説明する。

(1) 本発明の第1の実施例に係る二次電子放出材料 第1の実施例に係る二次電子放出材料について実験した 結果を以下に説明する。

## 【0013】(i) 試料の作成

図1に示す構造の調査用試料を作成した。調査用試料と して、2つの基板11,12間の隙間13に不活性ガス を封じてプラズマディスプレイパネルを形成したものを 用い、モノクロタイプのPDPの構成となっている。そ して、保護層として用いられるMg〇中のMgを置換す る元素に鉄(Fe),クロム(Cr)及びバナジウム (V) を用い、これらの含有量を種々変えたものを6種 類(#1~#6)作成した。

【0014】以下、調査用試料の構造について説明す る。即ち、一方の基板11はガラス基板21a上に帯状の 第1の表示電極22aと誘電体層23aと保護層24aとを順 に積層し、他方の基板12はガラス基板21b上に帯状の 第2の表示電極22bと誘電体層23bと保護層24bとを順 に積層した。なお、第1の表示電極22aと第2の表示電 極22 b にはそれぞれ引出配線25 a, 25 b が接続されてい る。

【0015】そして、保護層24a,24b同士が対面し、 第1の表示電極22aと第2の表示電極22bとが交差する ように2つの基板11、12が重ねられるとともに、基 板11,12間に放電用の不活性ガスを封入するための 30μmの隙間13が形成される。第1及び第2の表示 電極22a, 22bとしてスパッタ法により形成されたCr 膜/Cu膜/Cr膜の3層の導電膜を用い、誘電体層23 aとして塗布法等により形成された膜厚約20μmの酸 化鉛系(PbO系)のガラス膜を用いた。

[0016] また、保護層24a,24bとして遷移金属で ある鉄 (Fe), クロム (Cr) 及びバナジウム (V) でマグネシウム (Mg) を置換した膜厚約0.5 μmの MgO膜を用いた。MgO膜24a,24bは、含有量を種 々変えて鉄 (Fe), クロム (Cr) 及びバナジウム (V) を混合したMgO単結晶をるつぼに入れて溶融 し、これを電子ビーム蒸着(EB蒸着)することにより 形成された。

#### 【0017】(ii)実験方法

(a) フォトルミネッセンスの測定方法

Mg〇単結晶を用いたEB蒸着により得られた保護層24 a,24b中のMgと置換している元素を特定し、Fe, Cr及びVの量を検出するため、フォトルミネッセンス 測定を行った。

【0018】フォトルミネッセンス測定は、光励起され 50

-197-

BNSDOCID: <JP\_ 408236028A\_\_I\_> た電子が不純物イオンの準位に落ちるときに発生する光 を観測するものである。その光は不純物イオンに特有の 波長を有し、存在量に比例した強度を有するので、不純 物の種類や量を特定することができる。光源として波長 488nm及び514.5nmのArレーザを用い、そ れぞれパワー50mW, 36mWで保護層24a, 24bを 励起した。なお、励起波長488nm, 514.5nm の光はエネルギにすると、それぞれ2.54 e V, 2. 41eVに相当し、MgOのバンドギャップ7.75e Vの約1/3のエネルギしかないため、価電子帯(vale 10nce band) の電子を伝導帯 (conduction band ) にまで 励起することはできない。それにもかかわらず、ルミネ ッセンスが観測されるのは、図7に示すように、MgO のバンドギャップ内に酸素欠陥などの幾つかの局在準位 が存在し、これらから伝導帯に電子が励起されるためで あると考えられる。

【0019】(b) 放電維持最小電圧, 放電維持最大電 圧及び放電マージン電圧の測定方法

第1及び第2の表示電極22a,22bに周波数2KHzの交流電源を接続して徐々に電圧を増加していき、放電が20開始する電圧(放電開始電圧;VI)を測定した。また、放電の開始後に電圧を下げていき、放電が消滅するときの電圧(放電維持最小電圧;Vsmin)を測定した。更に、電圧を上げていき、放電が消滅するとき、或いは誘電体層23a,23bが破壊するときの電圧(放電維持最大電圧;Vsmax)を測定した。

【0020】また、放電維持最大電圧と放電維持最小電圧とから放電マージン電圧 (V s m a x - V s m i n)を計算した。

#### (iii) 実験結果について

(a) フォトルミネッセンスの測定結果

図3(a), (b)に測定結果を示す。図3(a)は測 定波長に対する発光強度を示す特性図であり、図3

(b) は測定波長700nm付近の拡大図である。ともに、縦軸は任意単位で表した発光強度を示し、横軸は線形目盛りで表した測定波長[nm]を示す。なお、図3(a)において、図の上部に示す横軸は測定波長に対応する光子のエネルギ[eV]を示す。

【0021】図3(a)及び図3(b)に示すように、 幾つかの特徴的なピークが観測された。ピーク位置を示 40 す測定波長は光源の励起波長488nm,514.5n mによって変化しないことから、ラマン効果でなく、ル ミネッセンスにより出現しているものだと判断すること ができる。なぜなら、ラマン効果によるピークは光とフ ォノンとの相互作用によるものであるため、励起波長が 変化すると、ラマン散乱のピーク位置も励起波長の変化 量だけシフトするからである。

【0022】以下、ピークに対応する不純物の種類を特定する。凡そ650 $\sim$ 920nmの測定波長の範囲で観測されるルミネッセンスは過去に観測されているので、

これらのデータを基にした。文献〔S. Datta, K. E. Aeberli, I. M. Boswarva, and D. B. Holt, J. Microscopy 118(1980) 367 によれば、 $200\sim250$  ppmのFeをドープしたMgOのカソードルミネッセンス測定結果が記載されており、688, 706, 723, 747 nmの明瞭なピークが観測されている。従って、図中、これらに近い

ており、688,706,723,747nmの明瞭なピークが観測されている。従って、図中、これらに近い位置にあるピークがFe元素の存在を示していると考えられる。

【0023】更に、文献 [C. C. Chao, J. Phys. Chem. Solid s, 32(1971)2517 によるMgO中のCr<sup>3</sup> + からのルミネッセンス測定結果は、698,712,720,725 nmの発光を観測していると考えられる。従って、図中、これらに近い位置にあるピークがCr元素の存在を示していると考えられる。また、659.5~680 nmの領域の発光はMn<sup>4</sup> + からのものであるとの報告 [K. Dunphy, and W. W. Duley, J. Phys. Chem. Solids, 51(1990)1077 があり、660 nmのルミネッセンスがそれに対応していると考えられる。従って、図中、これらに近い位置にあるピークがMn元素の存在を示していると考えられる。

【0024】更に、880~920nmに見られる発光に関して、文献〔I. Femandez and J. Llopis, Phys. stat. sol. (a) 108(1988) K163 によれば、図中、特に870nmの強い発光は、 $V^2$  + からのルミネッセンスであると考えられる。

(b) 放電維持最小電圧, 放電維持最大電圧及び放電マージン電圧の測定結果

測定波長700,720,870nmの発光強度〔cps〕と放電維持最小電圧(Vsmin)、放電維持最大30 電圧(Vsmax)〔V〕との関係を図4(a)に示す。Vsmin,Vsmaxの値は、試料を1時間エージングした後の測定値である。図4(a)からVsmaxは720nmの発光強度とほぼ比例関係にあることが分かる。

【0025】また、放電マージン電圧(Vsmax-Vsmin)と各発光強度との関係を図4(b)に示す。 放電マージン電圧は870nmの発光強度とほぼ反比例 の関係にあることが分かる。これらの間の相関をより明確にするため、各発光強度に対するVsmin, Vsmax, Vsmax-Vsminの依存性をそれぞれ図5(a),(b),図6に示す。各図中、データの傾向を実線で示した。

【0026】図6の放電マージン電圧については、興味ある結果が得られた。即ち、測定波長700nmの発光強度は、放電マージン電圧に対してほぼ一定であるのに対して、測定波長720nm,870nmの発光強度は大きく変化している。放電マージン電圧が11Vを境にして高くなると測定波長720nmの発光強度が急速に増加する。これは、少なくともFe及びCrのうちいずれかのMg置換量が増加するほど、バンドギャップ内に

50

不純物準位が多数形成されること、そこに高いエネルギを持った電子がトラップされて不純物準位の基底状態に 遷移すること、それにより、Mg〇の表面から2次電子が多数発生することを示していると考えられる。

【0027】一方、放電マージン電圧が11Vを境にして高くなると測定波長870nmの発光強度は減少する。以上から、PDPの保護層に用いられるMgO膜中のFe及びCrからの発光強度が強く、或いはVからの発光が弱い場合に、放電マージン電圧が高くなることがわかった。これは、少なくともFe及びCrのうちいず 10れかでMgを置換したことによるため、或いはこれにV添加の効果が加わったことによるためと考えられる。

【0028】なお、放電開始電圧(Vf)については、データを取得していないが、MgOの表面から2次電子が多数発生していると予想されるため、保護層に接する不活性ガスの放電が促進されるため、放電開始電圧(Vf)も下がると考えられる。

(2) 本発明の第2の実施例に係るプラズマディスプレイパネル

以下に、第2の実施例に係るカラーPDPについて図2 (a), (b)を参照しながら説明する。保護層38として上記の二次電子放出材料を用いている。図2 (a), (b)は、それぞれカラー表示が可能な面放電型PDPの構成を示す斜視図及び部分断面図である。

【0029】図中、31は前面ガラス基板、32a、32b は前面ガラス基板 31表面に形成され、一方向に並行して延びる2つ一組の帯状の表示電極対で、それぞれCr 膜/Cu膜/Cr 膜の三層の導電膜からなる。33は表示電極32a、32bを被覆して形成された厚さ約20 $\mu$ m の酸化鉛系(PbO系)のガラス層(誘電体層)である。

【0030】34は第1の実施例に示した二次電子放出 材料からなる保護層である。以上が一方の基板14を構 成する。35は前面ガラス基板31と対向するように形 成される背面ガラス基板、36a、36bは背面ガラス基板 35上に形成され、一方向に互いに並行する帯状の仕切 り壁、37は仕切り壁36a,36b間の凹部に仕切り壁36 a、36bに沿って形成されたアドレス電極(書き込み電 極)、38はアドレス電極37を被覆する蛍光体で、ア ドレス電極37と蛍光体38は、例えば、赤を表示す。 なお、符号を付けていないが、赤の表示部の隣には横並 びに緑、青、赤・・の表示が順に並んでいる。各色の蛍 光体は互いに異なる材料からなる。青の場合、例えばBa MgAl14023:En2+が用いられ、緑の場合、例えばBaAl120 19:Mnが用いられ、赤の場合、例えばYo.65Gdo.85BO3:En 3+ が用いられる。各アドレス電極37及び蛍光体38 間は仕切り壁36a、36bにより仕切られている。

【0031】以上が他方の基板15を構成する。なお、 実際のPDPでは、仕切り壁、アドレス電極、蛍光体及 び表示電極は上記説明したのと同様な構成で多数形成さ れているが、上記の説明では、簡単のため、1組しか説明していない。背面ガラス基板 35 の蛍光体 38 と前面ガラス基板 31 の表示電極32a, 32 b とが数十 $\mu$ mの隙間 39 をあけて対面し、かつ表示電極32a, 32 b と背面ガラス基板 35 のアドレス電極 37 とが交差するように基板 14, 15 は重ね合わされる。

【0032】図2(b)は仕切り壁36aと仕切り壁36bとの間の凹部の隙間39を示す部分断面図で、凹部にネオン(Ne)とキセノン(Xe)の混合ガスやヘリウム(He)とXeの混合ガス等の不活性ガスを減圧封入している。上記のPDPを動作させる場合、表示電極32a及び32bの間に放電開始前の放電維持電圧(交流又は直流)を印加して誘電体層33に電荷を蓄積しておく。この状態で、アドレス電極37に放電開始電圧に達するように電圧(交流又は直流)を印加することにより放電を起こさせる。これにより、凹部の隙間39にプラズマを発生させ、そのプラズマから発する励起光により蛍光体38が発光し、カラー表示がなされる。

【0033】上記の第2の実施例に係るカラーPDPに おれば、保護層34の材料として第1の実施例に係る二 次電子放出材料を用いているので、二次電子放出量が増 え、封入された不活性ガスの電離が促進される。これに より、放電開始電圧を下げることができるので、放電維 持電極間の間隔を狭くし、カラーPDPの高精彩化を図 ることができる。

【0034】また、放電マージン電圧を広くすることができるので、PDPを安定に動作させることができる。なお、第2の実施例では、面放電型PDPに本発明を適用しているが、これに限らず、不活性ガスが封入され、不活性ガスに接する保護層からの二次電子放出を利用して不活性ガスの放電を促進する構成のPDPに本発明を適用することができる。

[0035]

【発明の効果】以上のように、本発明に係るプラズマディスプレイ用二次電子放出材料によれば、MgOを構成するMgの一部が少なくともFe, Cr及びVのうちいずれか一つの元素で置換されている。このため、2次電子放出量が増えるので、放電が促進され、放電開始電圧が下がり、かつ放電マージン電圧が広くなる。特にVの量はFeとCrの総量よりも少なくすることにより、その効果を高めることができる。

【0036】また、本発明に係るプラズマディスプレイパネルによれば、放電開始電圧を下げることができるので、放電維持電極間の間隔を狭くし、プラズマディスプレイパネルの高精彩化を図ることができる。しかも、放電マージン電圧を広くすることができるので、プラズマディスプレイパネルを安定に動作させることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係る二次電子放出材料 を調査するためのPDPについて示す断面図である。

*50* 

【図2】本発明の第2の実施例に係る面放電型PDPに ついて示す斜視図及び断面図である。

【図3】本発明の第1の実施例に係る二次電子放出材料 のフォトルミネッセンスの調査結果について示す特性図 である。

【図4】本発明の第1の実施例に係る二次電子放出材料 の放電維持最小電圧、放電維持最大電圧及び放電マージ ン電圧の調査結果について示す特性図である。

【図5】本発明の第1の実施例に係る二次電子放出材料 の発光強度に対する放電維持最小電圧及び放電維持最大 10 電圧依存性の調査結果について示す特性図である。

【図6】本発明の第1の実施例に係る二次電子放出材料 の発光強度に対する放電マージン電圧依存性の調査結果 について示す特性図である。

【図7】本発明の第1の実施例に係る二次電子放出材料

のバンド構造について示す図である。

【図8】従来例に係るPDPについて示す断面図であ

【符号の説明】

11, 12, 14, 15 基板、

13,39 隙間、

21a, 21b, 31, 35 ガラス基板、

22a、32a 第1の表示電極、

22b, 32b 第2の表示電極、

23a, 23b, 33 誘電体層、

24a, 24b, 34 保護層、

25a, 25b 引出し配線、

36a, 36b 仕切り壁、

37 アドレス電極(書き込み電極)、

38 蛍光体層。

[図1] [図2]

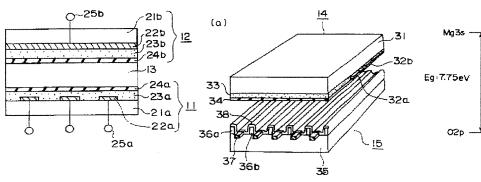


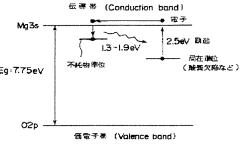


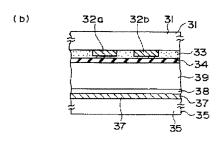






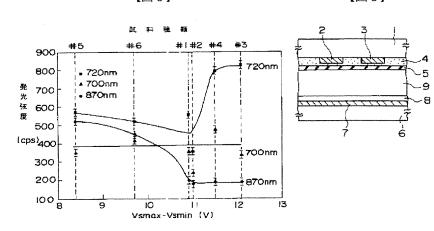




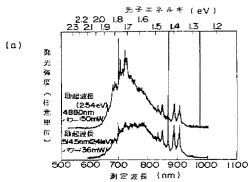


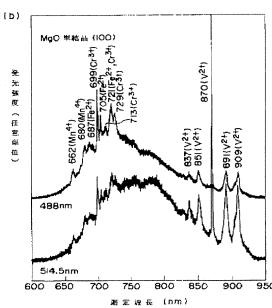
[図6]

[図8]

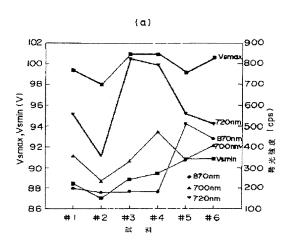


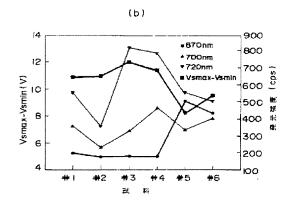






## [図4]





【図5】

